

製品規格/Product Specification 品種名/Type Number: UNR311100 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">L</span> 1)	DESIGNED	CHECKED	CHECKED	APPROVED

種別/Type	シリコントランジスタ/Silicon Transistors					
用途/Application	デジタル回路用/Digital Circuit					
構造/Structure	PNPエピタキシャルプレーナ形/PNP Epitaxial Planar Type					
外形/Out line	SSSMini3-F1			マーク記号/Marking	6A	
絶対最大定格/ Absolute Maximum Ratings	V <sub>CB0</sub>	V <sub>CE0</sub>	I <sub>C</sub>	P <sub>T</sub>	T <sub>j</sub>	T <sub>stg</sub>
	-50	-50	-100	100	125	-55~+125
	(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(°C)

電気的特性/Electrical characteristics (T<sub>a</sub>=25±3°C)

項目/Item	記号/ Symbol	測定条件/Measuring condition	typ.	Limit		Unit
				min.	max.	
コレクタ耐圧 Collector to Base Voltage	V <sub>CB0</sub>	I <sub>C</sub> =-10μA, I <sub>E</sub> =0		-50		V
コレクタ耐圧 Collector to Emitter Voltage	V <sub>CE0</sub>	I <sub>C</sub> =-2mA, I <sub>B</sub> =0		-50		V
コレクタ遮断電流 Collector Cutoff Current	I <sub>CB0</sub>	V <sub>CB</sub> =-50V, I <sub>E</sub> =0			-0.1	μA
コレクタ遮断電流 Collector Cutoff Current	I <sub>CE0</sub>	V <sub>CE</sub> =-50V, I <sub>B</sub> =0			-0.5	μA
エミッタ遮断電流 Emitter Cutoff Current	I <sub>EB0</sub>	V <sub>EB</sub> =-6V, I <sub>C</sub> =0			-0.5	mA
直流電流増幅率 Collector to Emitter Saturation Voltage	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =-10V, I <sub>C</sub> =-5mA		35		-
コレクタ飽和電圧 Collector to Emitter Saturation Voltage	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =-10mA, I <sub>B</sub> =-0.3mA			-0.25	V
ハイレベル出力電圧 Output Voltage High Level	V <sub>OH</sub>	V <sub>CC</sub> =-5V, V <sub>B</sub> =-0.5V, R <sub>L</sub> =1kΩ		-4.9		V
ローレベル出力電圧 Output Voltage Low Level	V <sub>OL</sub>	V <sub>CC</sub> =-5V, V <sub>B</sub> =-2.5V, R <sub>L</sub> =1kΩ			-0.2	V
入力抵抗 Input Resistance	R <sub>I</sub>		10	-30%	+30%	kΩ
抵抗比率 Resistance Ratio	R <sub>1</sub> /R <sub>2</sub>		1.0	0.8	1.2	-
トランジション周波数 Gain Bandwidth Product	f <sub>T</sub>	V <sub>CB</sub> =-10V, I <sub>E</sub> =1mA, f=200MHz	80			MHz

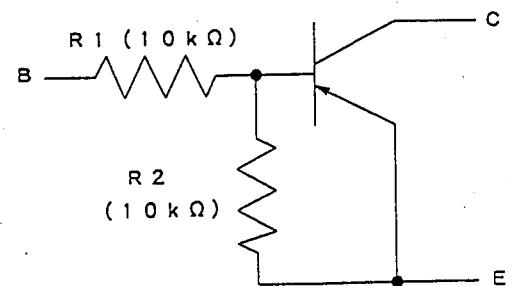
Note: 測定方法は、日本工業規格 JIS C 7030 トランジスタ測定方法による。

Measuring methods are based on JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD JIS C 7030 Measuring methods for transistors.

1) 包装/Packing

Code	包装形態 / Packing form
L	エポキシタイプ/embossed TX type

内部接続図/Internally connected circuit



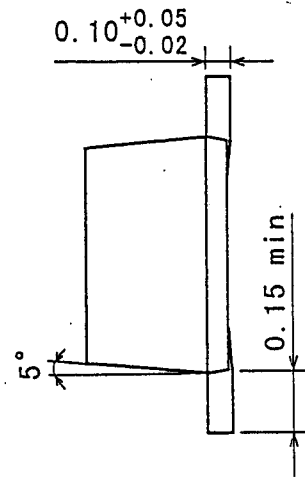
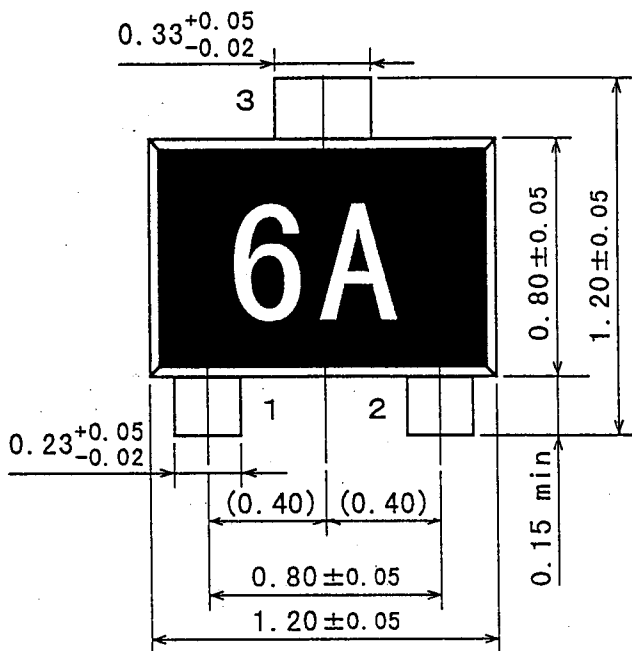
02.01.24			
----------	--	--	--

製品規格/Product Specification

外形図/Out Line

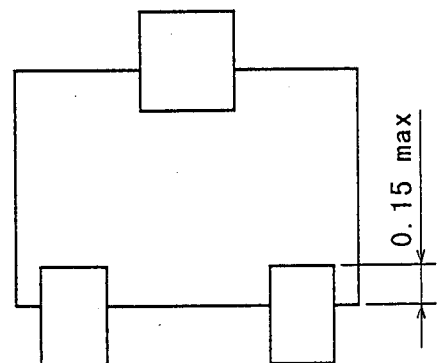
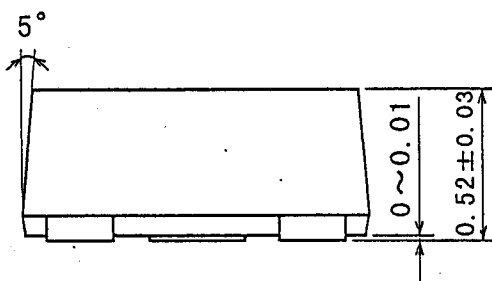
品種名/Type Number: UNR 3 1 1 1 0 0 L  
1)

単位/Unit : mm



注) 品種略号のみ表示  
Display at trademark

- 1. Base
- 2. Emitter
- 3. Collector



項目/Item	内容/contents
リード材質/Lead Material	銅系/Cu
リード処理/Lead Process	はんだめっき/Solder plating
モールド材質/Mold Material	エポキシ樹脂/Epoxy

02.01.24